

HK1225 使用说明书

一. 引脚排列

PIN 排列			PIN 描述		
N	1	28	Vcc	A0-A12	Address input
A1	2	27	WE	CE	Chip Enable (Low Enable)
A	3	26	CE2	GND	Ground
A	4	25	A8	DQ0-	Data In/Out
A	5	24	A9	Vcc	Power(+5V)
5	6	23	A11	WE	Write Enable (Low Enable)
A	7	22	OE	OE	Output Enable (Low Enable)
3	8	21	A10	NC	No Connect
A	9	20	CE	CE2	Chip Enable (High Enable)
A	10	19	DQ7		
DQ	11	18	DQ6		
DQ	12	17	DQ5		
DQ	13	16	DQ4		
GN	14	15	DQ3		

二. 读取模式

HK1225 在 WE (写使能) 被禁止 (high) 且 CE (片选) 被选中 (Low) 且 CE2 (片选 2) 被选中 (High) 并且 OE (读信号) 被使能 (Low) 执行一次读循环。13 个地址输入线 (A₀-A₁₂) 指定的唯一的地址定义将要被访问。最后输入信号稳定后 8 位数据输出驱动器将在 t_{ACC} 时序内得到有效数据。

<http://www.BDTIC.com/NVRAM>

三. 写模式

地址输入稳定后, HK1225 在 WE 和 CE 信号处于激活 (低电平) 状态且 CE2 (片选 2) 被选中 (High) 为写模式。最后出现的 CE 或 WE 下降沿将 决定写循环的开始, 写循环终止于 CE 或 WE 前边的上升边沿。在写循环内 所有地址输入必须保持有效。在下一个循环能被初始化前, WE 写信号必须 将高电平保持最少记录时间 (t_{WR}) 写循环期间 OE 控制信号应当保持失效 (高电平) 避免总线冲突, 如果输出总线已经有效 (CE 和 OE 激活) 则信号可以在 t_{ODW} 时序内从下降边沿开始禁止输出。

四. 数据保存模式

HK1225 为 Vcc 提供全部功能, 当 Vcc 大于 4.5 伏或 4.75 伏, 写保护为 4.35 伏或 4.75 伏。当 Vcc 掉电时保存数据, 没有任何附加支持电路的需要。HK1225 通常监视 Vcc。如果支持电压降低, RAM 自动写保护其本身。所有对 RAM 的输入变为“不接收”, 所有输出为高电阻。当 Vcc 降低到大约 3.0 伏时, 电源转换电路将用锂电池向 RAM 供电保存数据。电压升高时, 当 Vcc 升高到大约 3.0 伏时, 电压转换电路将外部 Vcc 与 RAM 连接。正常 RAM 操作在 Vcc 超过 4.5 伏或 4.75 伏后能够重新开始。

五. 出厂状态及运输

HK1225 从宏空半导体出厂均保证满电量。运输及使用中的重力加速度不应超出 1.5G 否则影响寿命。

六、验收及服务

本产品验收期为 1 个月即自客户得到本产品后对以下各项性能指标进行验收，如果异议应在 1 个月内提出更换或退货。质量保证期即服务期为一年，如产品在一年内非使用问题而产生的产品质量问题并且未经使用损坏的经 我公司检验认可可以给予更换。我公司拥有对以上条款的最终解释权。

七、各项指标

① 最大范围

各脚对地电压	-0.3~5.0V
储存温度	-40℃~70℃
焊接温度	200℃不能超过 5 秒
操作温度	0℃~55℃ 准工业级 0℃~70℃ 工业级-40℃~70℃

注：长期暴露在工作在以上最大范围下将影响使用周期

②推荐操作条件 (0℃to70℃)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS
Power Supply Voltage (HK1225)	VCC	4.5	5.0	5.5	V
Power Supply Voltage (HK1225N)	VCC	4.75	5.0	5.25	V
Logic 1	VIH	2.2	—	Vcc	V

③直流特性

(0℃to70℃;Vcc=5V±10%)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS
Input Leakage Current	I _{IL}	-5.0	—	+5.0	m
I/O Leakage Current CE≥VIH≤VCC	I _{I/O}	-5.0	—	+5.0	m
Output Current @2.4V	I _{OH}	-1.0	—	—	m
Output current @0.4V	I _{OL}	2.0	—	—	m
Standby Current CE=2.2V, CE2=0V	I _{CCS1}	—	5.0	10.0	m
Standby Current CE=Vcc-0.5V, CE2=0V	I _{CCS2}	—	3.0	5.0	m
Operating Current	I _{CCO1}	—	5	45	m
Write Protection Voltage (HK1225)	V _{TP}	4.25	4.37	4.5	V
Write Protection Voltage (HK1225N)	V _{TP}	4.5	4.75	4.85	V

④读写电特性

(0℃to70℃;Vcc=5V±10%)

PARAMETER	SYM	HK1225-70		HK1225-85		HK1225-100		UNITS	NOTE S
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
Read Cycle Time	t _{RC}	70	—	85	—	100	—	ns	—
Access Time	t _{ACC}	—	70	—	85	—	100	ns	—
OE to Output Valid	t _{OE}	—	35	—	45	—	50	ns	—
OE to Output Valid	t _{CO}	—	70	—	85	—	100	ns	—
OE or CE Output Active	t _{COE}	5	—	5	—	5	—	ns	5
Output High Z from Dissection	t _{OD}	—	25	—	30	—	35	ns	5
Output Hold from dress Change	t _{OH}	5	—	5	—	5	—	ns	—
Write Cycle Time	t _{WC}	70	—	85	—	100	—	ns	—
Write Pulse Width	t _{WP}	55	—	65	—	75	—	ns	3
Address Setup Time	t _{AW}	0	—	0	—	0	—	ns	—
Write Recovery Time	t _{WR1}	5	—	5	—	5	—	ns	
	t _{WR2}	15	—	15	—	15	—	ns	
Output High Z from WE	t _{ODW}	—	25	—	30	—	35	ns	5
Output Active from WE	t _{OEWE}	5	—	5	—	5	—	ns	5
Data Setup Time	t _{DS}	30	—	35	—	40	—	ns	4
Data Hold Time	t _{DH1}	0	—	0	—	0	—	ns	
	t _{DH2}	10	—	10	—	10	—	ns	

⑤建议电源上下电时间

SYM	PARAMETER	MIN	MAX	UNITS	NOTE
tPD	CE at VIH before Power-Down	10	—	μs	—
tF	Vcc Slew from 4.5v to 0v(CE at VIH)	300	—	μs	—
tR	Vcc Slew from 0v to 4.5v(CE at VIH)	0	20	μs	—
tREC	CE WE at VIH after Power-Up	20	125	m	—

(T_A=25°C)

SYM	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTE
t DR	Expected Data Retention Time	—	10	—	years	9,10

<http://www.BDTIC.com/NVRAM>